

Кремниевый фотодиод 760 нм, ТО-корпус — техническое описание

P/N : WST9-05G

ОСОБЕННОСТИ

Высокая чувствительность; низкий темновой ток; спектральная чувствительность 430–1100 нм

ПРИМЕНЕНИЕ

Датчики O2

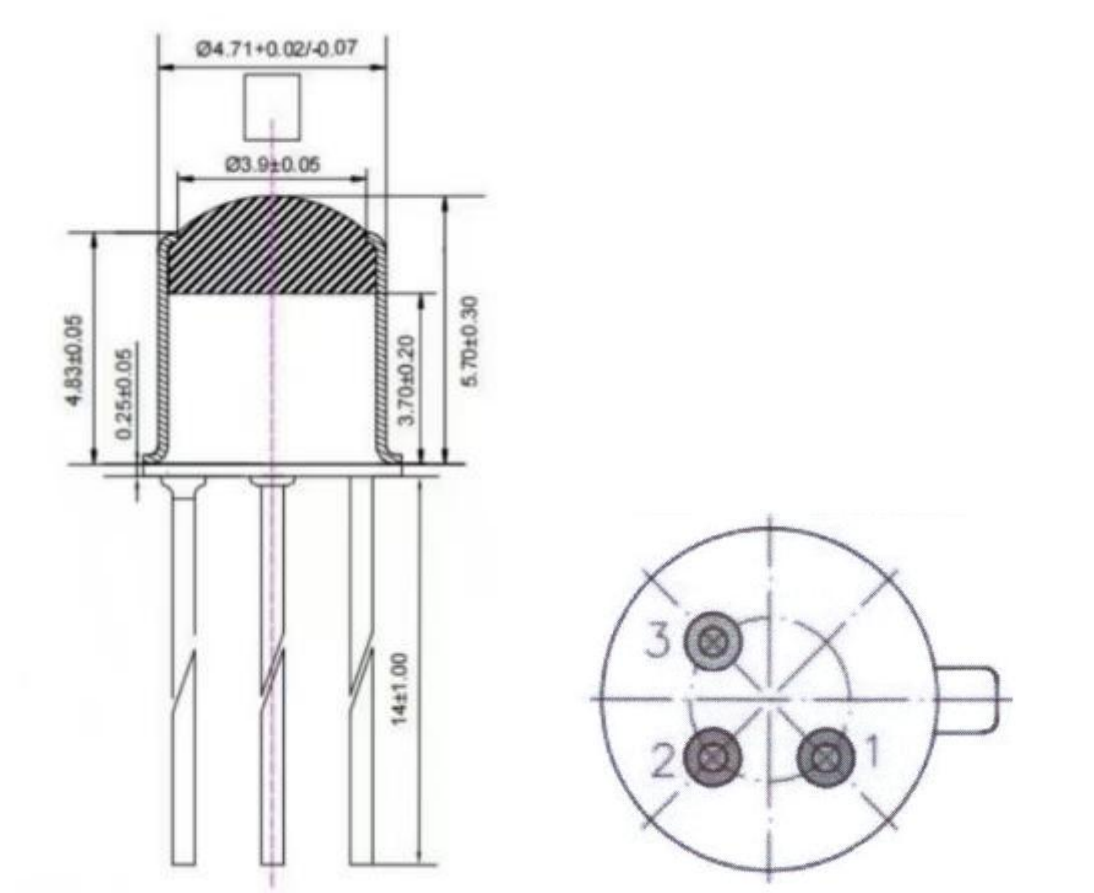
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Рабочая температура	TSTG	°C	-40	125
Температура хранения	TC	°C	-40	85
Температура (время) пайки	TL	°C		260 / 10 с

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100µA	60			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			10	нА
Чувствительность	R			0.5		А/Вт
Рабочий диапазон длин волн	λ		430	760	1100	нм
Емкость	Cj	VR=3V, H=0, F=1MHz		9		пФ

Назначение выводов и габаритный чертёж:



№ вывода	Название
1	PD+
2	PD-
3	GND